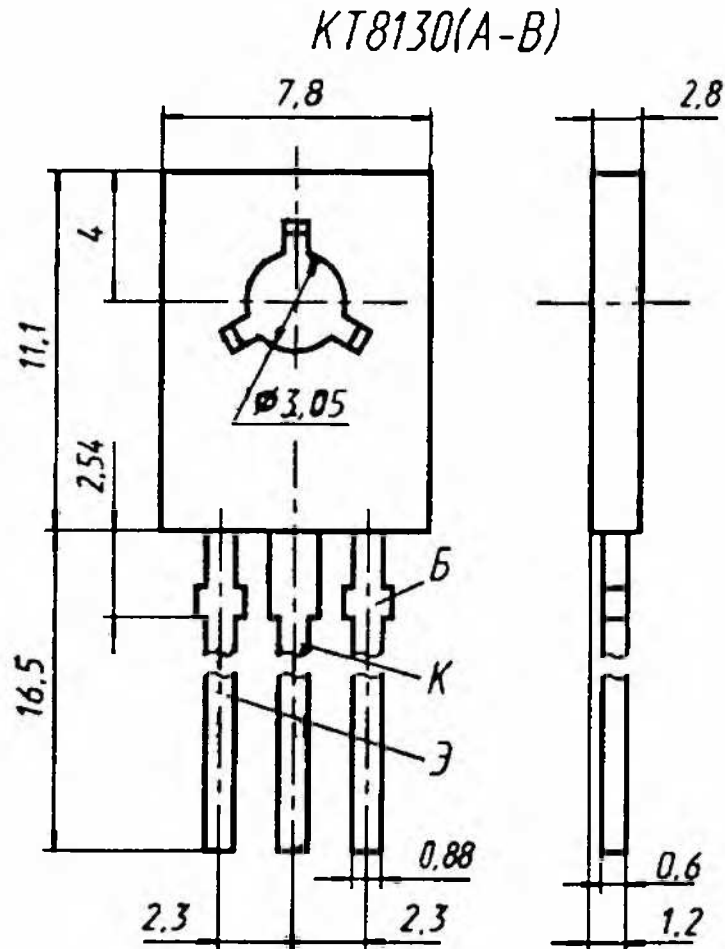


КТ8130А, КТ8130Б, КТ8130В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* составные усилительные. Предназначены для применения в усилителях мощности и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 3$ В:

$I_3 = 0,5$ А	500...15000*
$I_3 = 2$ А	750...15000*
$I_3 = 4$ А	100...15000*

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 0,5$ А, не менее

25 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 0,1$ А, не менее:

КТ8130А	40 В
---------------	------

КТ8130Б	60 В
КТ8130В	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер,
не более:

при $I_K = 2$ А, $I_B = 8$ мА	2 В
при $I_K = 4$ А, $I_B = 40$ мА	3 В

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

КТ8130А	40 В
КТ8130Б	60 В
КТ8130В	80 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

при $R_{БЭ} = 1$ кОм:

КТ8130А	40 В
КТ8130Б	60 В
КТ8130В	80 В

Постоянное напряжение база—эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора

4 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора при $T_K = -45...+25$ °С

20 Вт

Температура *p-n* перехода

+150 °С

Температура окружающей среды

-45... $T_K =$
= +100 °С

Транзисторы являются комплементарными с транзисторами КТ8131А—КТ8131В.